	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XP030J	文件编号	XS-W-157
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	1/3

1 主要用途及主要特点

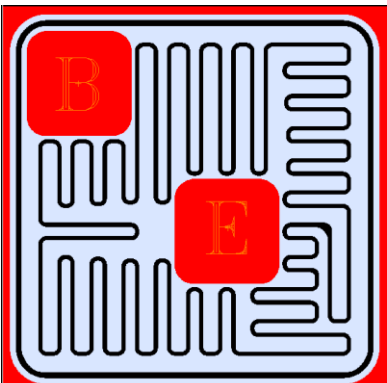
1.1 主要用途

用 W2XP030J 芯片封装的成品管主要用于低压电源调整电路及一般高频放大电路。

1.2 主要特点

- 电流特性好
- 饱和电压低

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	1.1×1.1	
	芯片厚度 (μm) (推荐)	250±20	
	划片道尺寸 (μm)	50	
	键合区面积 (μm ²)	基区	300×300
		发射区	300×300
	钝化层		Si ₃ N ₄
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	4.0±0.6
	背面电极	金属	银
	硅片直径 (mm)		φ125
	装片要求(推荐)		铅锡烧结

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, T_{amb} = 25℃

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V _{CB0}	80	V	推荐封装形式: TO-126 BD140 推荐成品型号: BD238
集电极-发射极电压	V _{CE0}	80	V	
发射极-基极电压	V _{EB0}	5	V	
集电极电流	I _C	1.5	A	
耗散功率(Ta=25℃)	P _{tot}	1.25	W	
结温	T _j	150	℃	
贮存温度	T _{stg}	-55~150	℃	

3.2 电参数


除非另有规定, T_{amb} = 25℃

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I _{CB0}	V _{CB} = -80V, I _E = 0			1	μA
发射极-基极截止电流	I _{EB0}	V _{EB} = -5V, I _C = 0			1	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h _{FE}	V _{CE} = -2V, I _C = -150mA	40		250	
集电极-发射极饱和电压	V _{CEsat}	I _C = -500A, I _B = -50mA			0.5	V
特征频率	f _T	V _{CE} = -10V, I _C = -100mA f = 30MHZ	30			MHz

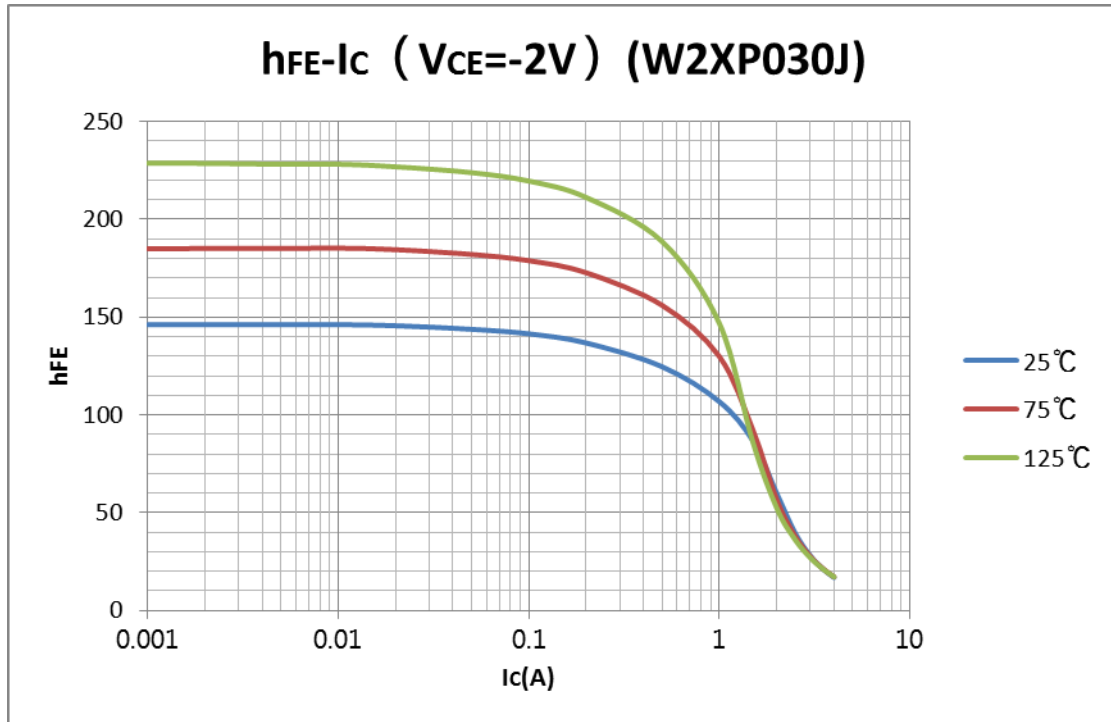
江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
 电话: (0510) 86851182

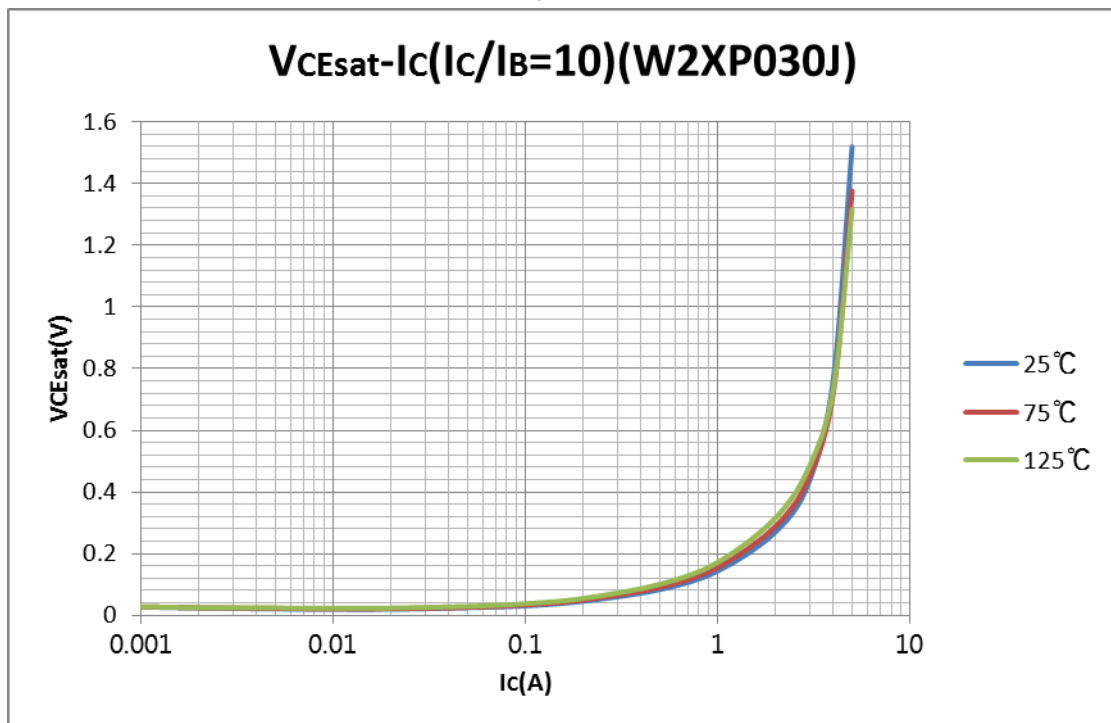
网址: <http://www.xs-elec.com>
 传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XP030J	文件编号	XS-W-157
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	2/3

3.3 典型特性曲线



图一 h_{FE}-I_C 高温对比曲线



图二 V_{CEsat}-I_C 高温对比曲线


江阴新顺微电子有限公司

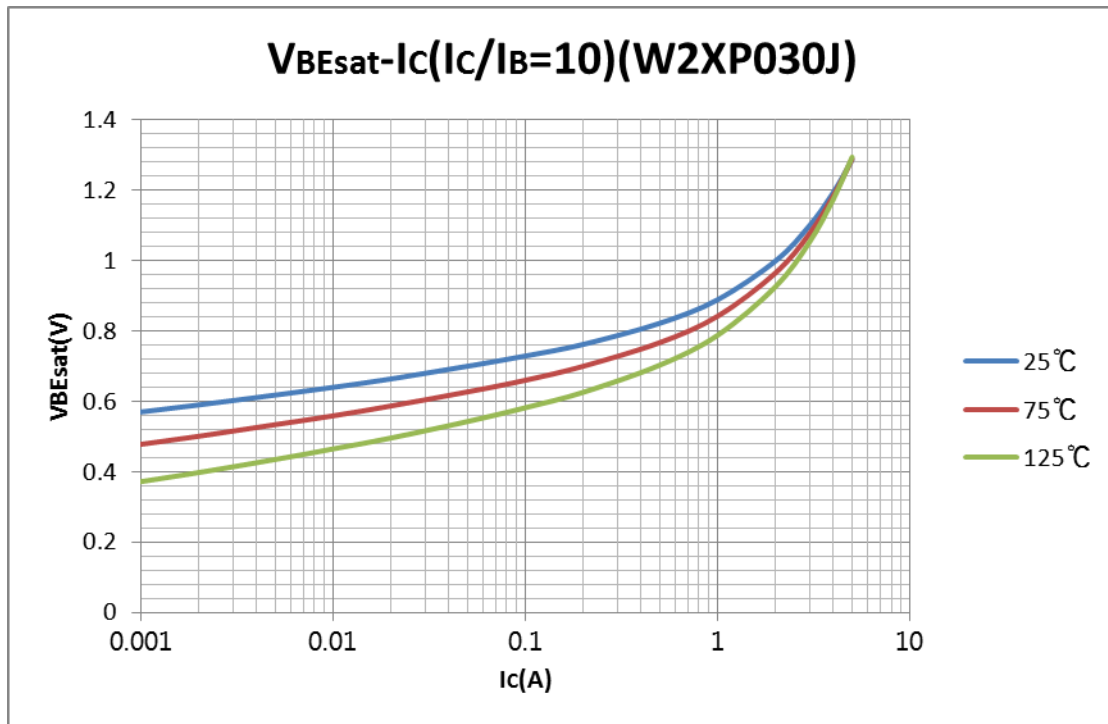
地址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：<http://www.xs-elec.com>

电话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XP030J	文件编号	XS-W-157
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	3/3



图三 $V_{BEsat}-I_C$ 高温对比曲线

注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：<http://www.xs-elec.com>

电 话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532